06.1;13.1

Спин-волновой резонанс в синтетическом антиферромагнетике $[(Co_{0.88}Fe_{0.12})/Cu]_N$

© И.Г. Важенина¹, Р.С. Исхаков¹, М.А. Миляев², Л.И. Наумова², М.В. Рауцкий¹

¹ Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск, Россия

E-mail: irina-vazhenina@mail.ru

Поступило в Редакцию 26 июня 2020 г. В окончательной редакции 27 июля 2020 г. Принято к публикации 27 июля 2020 г.

Методом спин-волнового резонанса исследован синтетический антиферромагнетик $[(Co_{0.88}Fe_{0.12})/Cu]_N$ во всем диапазоне углов внешнего постоянного магнитного поля относительно нормали к поверхности пленки. Исследования демонстрируют, что рассматриваемая сверхрешетка представляет собой две обменно-связанные магнитные подсистемы, каждая из которых проявляется в регистрируемых спектрах в виде серий спинволновых мод. Установлена зависимость величины линейной области распространения стоячей спиновой волны от ориентации образца во внешнем магнитном поле.

Ключевые слова: спин-волновой резонанс, синтетический антиферромагнетик, константа обменного взаимодействия.

DOI: 10.21883/PJTF.2020.21.50193.18433

Сверхрешетки $[\mathrm{Co}_{1-x}\mathrm{Fe}_x/\mathrm{Cu}]_N$ обладают уникальным сочетанием определенных магнитных свойств, которое позволяет использовать их в магнитных сенсорах с рекордными техническими параметрами [1-3]. Результаты исследований микроволнового гигантского магниторезистивного эффекта $(\mu\mathrm{GMR})$ [1-3] демонстрируют эффективность электродинамических методик сантиметрового диапазона длин волн для описания электромагнитных свойств сверхрешеток.

Традиционными методами измерения динамических характеристик магнитных систем являются методы ферромагнитного (ФМР) и спин-волнового резонанса (СВР) [4–6]. Угловые зависимости спектров СВР и ФМР позволяют определить такие параметры магнитной системы, как эффективная намагниченность M_{eff} , константа обменного взаимодействия A, константы ортогональной анизотропии и анизотропии в плоскости пленки, константа поверхностной анизотропии.

Результаты теоретических [7,8] и экспериментальных [9,10] исследований динамических характеристик мультислойных структур демонстрируют зависимость формы спектра как от структурных (толщины слоев и их количества), так и от магнитных (величины намагниченности, поля анизотропии) параметров отдельного слоя [11]. Таким образом, методы ФМР и СВР позволят установить интегральные магнитные параметры планарной сверхрешетки [CoFe/Cu] и оценить их взаимосвязь с другими эффектами, наблюдаемыми на данных композитах [12].

Исследованы динамические свойства сверхрешетки $[(\mathrm{Co}_{0.88}\mathrm{Fe}_{0.12})/\mathrm{Cu}]_N$ с толщиной немагнитной прослойки $t_s=0.95\,\mathrm{nm}$. Образец синтезировался методом магнетронного напыления с использованием установки MPS-4000-C6 [13]. В качестве подло-

жек использовалось стекло Corning. Образец представлял собой планарную наноструктуру с композицией $Ta(5\,nm)/Ni_{48}Fe_{12}Cr_{40}(5\,nm)/[Co_{88}Fe_{12}(1.5\,nm)/Cu(0.95\,nm)]_{24}/Ta(5\,nm).$

Рентгеновские исследования на дифрактометре ДРОН-3М с использованием CoK_{α} -излучения показали, что сверхрешетка обладает совершенной структурой слоев с ГЦК-решеткой и аксиальной текстурой (111) с осью, нормальной к плоскости слоев. Результаты измерения микроволнового GMR исследуемой структуры представлены в [3]. Согласно зависимостям M(H), измеренным для подобных структур [13], величина поля насыщения принимает значения в диапазоне 200—300 Ое при различных составах буферного слоя.

Измерения СВЧ-спектров пленок было выполнено на оборудовании КРЦКП ФИЦ КНЦ СО РАН (спектрометре ELEXSYS E580 Bruker, Германия) при комнатной температуре в X-диапазоне (частота накачки резонатора $f=9.47\,\mathrm{GHz}$), образец помещался в пучность переменного магнитного поля h_\sim проходного резонатора. Постоянное магнитное поле **H** изменялось как в плоскости пленки по углу φ , так и в плоскости, параллельной нормали пленки, при различных значениях угла θ , который отсчитывался от нормали к плоскости пленки.

Зависимость положений резонансных полей H_n от волнового вектора k, который связан с номером моды n выражением $k=n\pi/d$ (d — толщина пленки, n принимает значения 1, 3, 5, . . . для объемных спиновых мод и n=0 для однородной моды Φ MP), при $\theta=90^\circ$ имеет вид [14]:

$$H_n = \left\{ \left[\left(\frac{\omega}{\gamma} \right)^2 + (2\pi M_{eff})^2 \right]^{1/2} - 2\pi M_{eff} \right\} - \eta_{eff} k_n^2. \tag{1}$$

² Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия

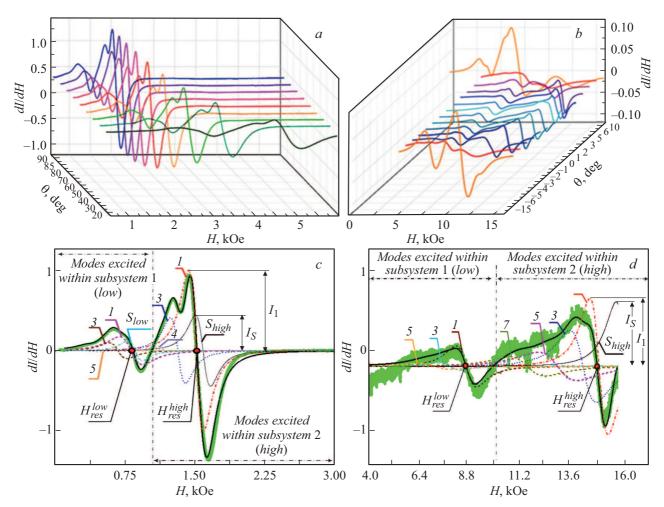


Рис. 1. Эволюция спектров в диапазоне углов от 90 до 20° (a) и от 10 до -15° (b), а также пример разложения экспериментальных спектров при $\theta = 90$ (c) и 0° (d). Буквой S обозначены поверхностные моды, буквой I — интенсивности поверхностной и первой объемной мод. Линиями (на частях c и d), обозначенными арабскими цифрами, отмечены объемные стоячие спиновые моды.

Позиции резонансных полей H_n при $\theta=0^\circ$ определяются как [15]:

$$H_n = \frac{\omega}{\gamma} + 4\pi M_{eff} - \eta_{eff} k_n^2, \tag{2}$$

где $\omega=2\pi f$ — циклическая частота $[s^{-1}]$, $\gamma=1.758\cdot 10^7\,[{\rm Hz/Oe}]$ — гиромагнитное соотношение, $\eta_{eff}=2A/M_s$ — спин-волновая жесткость $[{\rm Oe\cdot cm^2}]$, связанная с константой обменного взаимодействия $A\,[{\rm erg/cm}]$, M_S — намагниченность насыщения.

Вне зависимости от геометрии эксперимента СВР $(\theta=0)$ или 90°) эффективная обменная жесткость в полевых координатах вычисляется по формуле

$$\tilde{\eta}_{eff} = \frac{H_1 - H_n}{n^2 - 1}.\tag{3}$$

Вклад анизотропии можно оценить из уравнений ФМР для магнитно-анизотропных материалов, полученных в приближении эффективных полей [15], для $\theta=90^\circ$

$$\frac{\omega}{\nu} = \left[(H + H_{eff})(H + H_u) \right]^{1/2} \tag{4}$$

и для $heta=0^\circ$

$$\frac{\omega}{\gamma} = \left[(H - H_{eff})(H - H_{eff} - H_u) \right]^{1/2}.$$
 (5)

Здесь $H_{eff} = 4\pi M_S + H_K$ — эффективное поле, учитывающее влияние упругих напряжений, H_u — поле одноосной анизотропии.

Кривые СВЧ-поглощения синтетического антиферромагнетика $[{\rm CoFe/Cu}]_N$ при ориентации поля в плоскости пленки $(\theta=90^\circ)$ демонстрируют сложный спектр с неизменной структурой (одинаковые значения резонансного поля и ширины линии отдельных составляющих спектра) во всем диапазоне углов φ , что свидетельствует об изотропности магнитных параметров в плоскости пленки. Кривые СВЧ-поглощения, когда внешнее постоянное магнитное поле H изменяется относительно нормали к плоскости пленки, имеют вид сложного составного спектра во всем диапазоне углов θ (рис. 1,a и b). Экспериментальные СВЧ-спектры были разложены на составляющие с помощью дифференцированных функций Лоренца (см. пример на рис. 1,c и d).

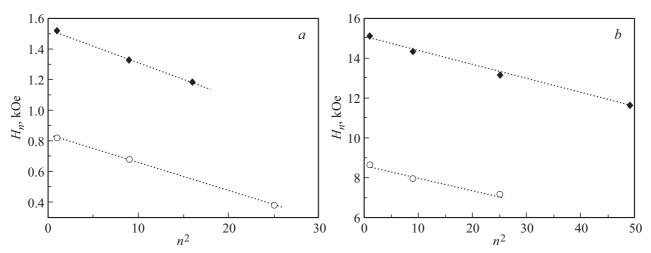


Рис. 2. Экспериментальные дисперсионные зависимости $H_n(n^2)$ для случая $\theta = 90~(a)$ и $0^\circ~(b)$. Ромбами отмечены значения для высокополевой части спектра, кружками — для низкополевой части спектра.

Анализ спектров позволяет сделать следующие выводы: во всем измеряемом диапазоне углов в пленке возбуждаются как стоячие объемные спиновые моды, так и поверхностные; спектр СВЧ при любом угле θ состоит из двух частей: низкополевой и высокополевой. Наличие в спектрах СВР двух частей, описываемых отдельными сериями объемных стоячих спиновых мод, дает основание рассматривать сверхрешетку как две магнитные подсистемы с различными величинами магнитных параметров. Способность методов ФМР и СВР фиксировать двухфазность продемонстрирована в [14,16].

Аппроксимация экспериментальных зависимостей H_n (n^2) при $\theta=90$ и 0° (рис. 2) позволяет определить величины резонансных полей ФМР (n=0), а выражения (4) и (5) позволяют оценить M_S и H_u для каждой подсистемы (см. таблицу).

С помощью (3) и зависимостей $H_n(n^2)$ (рис. 2) были рассчитаны величины эффективной обменной жесткости $\tilde{\eta}_{eff}$: $\tilde{\eta}_{eff}^{\perp} \approx 80$ Ое для обеих подсистем в случае $\theta=0^\circ$ и $\tilde{\eta}_{eff}^{\parallel} \approx 20$ Ое для обеих подсистем в случае $\theta=90^\circ$. В то же время известно, что в однородных пленках экспериментальные значения η_{eff} в обеих геометриях получаются равными [14]. Разницу в экспериментальных значениях $\tilde{\eta}_{eff}$ можно объяснить изменением линейного размера планарной области, в которой происходит возбуждение стоячей спиновой волны, т. е. некой эффективной толщины подсистемы d_{eff}^i . Последнее указывает, что для $\theta=0$ и 90° эффективное закрепление обменной спиновой волны осуществляется внутри пленки, но при

различных толщинах d_{eff}^i . В [17] обсуждалась возможность формирования узлов обменной спиновой волны внутри мультислойной пленки внутренними граничными условиями, а не традиционными киттелевскими граничными условиями на внешних поверхностях пленки. Особенности спектров СВР в двухслойных пленках, вызванные смещением узла стоячей спиновой волны с межслойной границы, экспериментально регистрировались в работе [18]. Мы предполагаем, что величина d_{eff}^i в различных геометриях меняется вдвое, что следует из экспериментально обнаруженного соотношения $(\eta_{eff}^i)_{eff}^i = 4$ (см. дополнительные материалы в онлайн-версии статьи).

Предполагая, что при $\theta = 90^{\circ} \ d_{eff}^{i} = 58.8 \, \mathrm{nm}$, и используя величину намагниченности насыщения M_{Shigh} таблицы и выражение (3), получим величиэффективной константы обменного взаимодействия $A_{eff} \sim 0.4 \cdot 10^{-7} \, {\rm erg/cm}$. Заметим, что величина A_{eff} для пленок ГЦК-Со (200 nm) оценивается как $1.3 \cdot 10^{-6} \text{ erg/cm}$ [10]; при уменьшении толщины Со величина A_{eff} может уменьшиться на порядок [19]. Сильное отличие A_{eff} для мультислойных систем с ультратонким слоем CoFe (~ 1.5 nm) при толщине немагнитной прослойкой $Cu\sim 0.95\,\mathrm{nm}$ от аналогичного параметра однослойных пленок объясняется интегральным вкладом в данный параметр парциальных обменных взаимодействий отдельных ферромагнитных слоев и парциального обмена между ферромагнитными слоями через немагнитную прослойку.

Магнитные параметры

Магнитные параметры		Подсистема 1	Подсистема 2
Резонансные	$ heta=90^\circ$	$H_{0 low}^{\parallel} = 840 \mathrm{Oe}$	$H_{0 high}^{\parallel} = 1550 \mathrm{Oe}$
поля ФМР	$ heta=0^\circ$	$H_{0low}^{\perp} = 8700\mathrm{Oe}$	$H_{0 high}^{\perp} = 15 100 \mathrm{Oe}$
Намагниченность на	Намагниченность насыщения		$M_{Shigh} = 939\mathrm{G}$
Поле одноосной кристаллической анизотропии		$H_{u low} \approx 3 \mathrm{Oe}$	$H_{uhigh}\cong -730\mathrm{Oe}$

Сверхрешетка $[(\text{Co}_{0.88}\text{Fe}_{0.12})/\text{Cu}]_N$ толщиной $\sim 60\,\text{nm}$ (в отличие от аналогичной системы толщиной $\sim 30\,\text{nm}$) представляет собой две обменно-связанные магнитные подсистемы, которые проявляются в виде двух наборов спиновых обменных стоячих мод в спектре CBP во всем диапазоне угла θ . Подсистемы обладают разными по знаку и величине одноосными перпендикулярными константами анизотропии. Обнаружено изменение величины линейной области распространения обменной спиновой волны в сверхрешетке в зависимости от ориентации пленки во внешнем постоянном магнитном поле. Выявленные особенности магнитной системы могут стать механизмом для управления величиной GMR при синтезе сверхрешеток.

Финансирование работы

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ (тема "Спин" № АААА-А18-118020290104-2) при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 20-42-660018).

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- [1] Ринкевич А.Б., Ромашев Л.Н., Устинов В.В. // ЖЭТФ. 2000. Т. 117. В. 5. С. 960–968.
- [2] Kuanr B.K., Kuanr A.V., Grünberg P., Nimtz G. // Phys. Lett. A. 1996. V. 221. P. 245–252.
- [3] Ринкевич А.Б., Пахомов Я.А., Кузнецов Е.А., Клепикова А.С., Миляев М.А., Наумова Л.И., Устинов В.В. // Письма в ЖТФ. 2019. Т. 45. В. 5. С. 42–44.
- [4] Гуревич А.Г. Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнетиках. М.: Наука, 1973. 591 с.
- [5] Ферромагнитный резонанс / Под ред. С.В. Вонсовский. М.: Физматгиз, 1961. 343 с.
- [6] Саланский Н.М., Ерухимов М.Ш. Физические свойства и применение магнитных пленок. Новосибирск: Наука, 1975. 221 с.
- [7] Ignatchenko V.A., Mankov Y.I., Maradudin A.A. // Phys. Rev. B. 2000. V. 62. P. 2181–2184.
- [8] Kruglyak V.V., Kuchko A.N. // Physica B. 2003. V. 339. P. 130– 133.
- [9] *Исхаков Р.С., Столяр С.В., Чеканова Л.А., Чижик М.В. //* ФТТ. 2012. Т. 54. В. 4. С. 704–708. http://journals.ioffe.ru/articles/580
- [10] Исхаков Р.С., Мороз Ж.М., Чеканова Л.А., Шалыгина Е.Е., Шепета Н.А. // ФТТ. 2003. Т. 45. В. 5. С. 846–851. http://journals.ioffe.ru/articles/4617
- [11] Khodadadi B., Mohammadi J.B., Jones J.M., Srivastava A., Mewes C., Mewes T., Kaiser C. // Phys. Rev. Appl. 2017. V. 8. P. 014024.
- [12] Устинов В.В., Ринкевич А.Б., Важенина И.Г., Миляев М.А. // ЖЭТФ. 2020. Т. 158. В. 1. С. 139–150. https://doi.org/: 10.31857/S0044451020070135

- [13] Банникова Н.С., Миляев М.А., Наумова Л.И., Проглядо В.В., Криницина Т.П., Чернышева Т.А., Устинов В.В. // ФММ. 2015. Т. 116. № 2. С. 165–170.
- [14] Исхаков Р.С., Середкин В.А., Чеканова Л.А., Яковчук В.Ю. // Письма в ЖЭТФ. 2002. Т. 76. В. 11. С. 779–783.
- [15] Kittel C. // Phys. Rev. 1958. V. 110. P. 1295–1297.
- [16] Morales M.A., Lassri H., Biondo A., Rossi A.M., Baggio-Saitovitch E. // J. Magn. Magn. Mater. 2003. V. 256. P. 93–99. https://doi.org/10.1016/S0304-8853(02)00386-4
- [17] Poimanov V.D., Kuchko A.N., Kruglyak V.V. // Phys. Rev. B. 2018. V. 98. P. 104418.
- [18] Исхаков Р.С., Яковчук В.Ю., Столяр С.В., Чеканова Л.А., Середкин В.А. // ФТТ. 2001. Т. 43. В. 8. С. 1462–1466. https://journals.ioffe.ru/articles/38276
- [19] Исхаков Р.С., Шепета Н.А., Комогорцев С.В., Столяр С.В., Чеканова Л.А., Бондаренко Г.Н., Мальцев В.К., Балаев А.Д. // ФММ. 2003. Т. 95. № 3. С. 37–42.